MoS₂/WSe₂-PVA 薄膜热光全光调制器(特邀)

王奕方,吴 侃,陈建平

(上海交通大学 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室,上海 200240)

摘 要: 全光调制器在全光信号处理和通信等全光应用中起着重要的作用。主要研究了基于MoS₂-PVA 薄膜实现的全光调制器。此外,也验证了 WSe₂-PVA 薄膜也可实现全光调制。该器件利用热光效应, 结合偏振干涉实现了全光调制,得到了长时间稳定输出的调制信号。将 980 nm 的脉冲信号作为控制 光,MoS₂ 或 WSe₂ 吸收光产生热量,使薄膜的折射率发生改变,从而改变 1 550 nm 信号光的偏振态,实 现 980 nm 控制光对 1 550 nm 光的调制。得到的 MoS₂-PVA 薄膜全光调制器的上升沿时间为 526 μS。 关键词: 全光器件; 非线性光学材料; 光开关器件; 相位调制 中图分类号: TN29 文献标志码: A DOI: 10.3788/IRLA201948.0103003

All-optical thermal modulator based on MoS₂/WSe₂-PVA thin film (invited)

Wang Yifang, Wu Kan, Chen Jianping

(State Key Laboratory of Advanced Optical Communication Systems and Networks, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: All-optical modulator plays an important role for various all-optical applications in optical communication. An all-optical modulator was mainly investigated based on few-layer molybdenum disulfide (MoS₂)-polyvinyl alcohol (PVA) thin films. In addition, an all-optical modulator based on few-layer tungsten disulfide (WSe₂)-polyvinyl alcohol (PVA) thin film was also demonstrated. The modulator was based on polarization interference and the thermo-optic effect of TMDs-PVA thin film. A long-time stable modulated output was obtained. By absorbing the pump at 980 nm, MoS₂ or WSe₂ generates heat, changes the refractive index of thin film and modifies the polarization of the incident light at 1550 nm. The obtained thermal all-optical modulator based on MoS₂-PVA thin film has a rise time of 526 μ s. Key words: all-optical devices; nonlinear optical materials; optical switching devices;

phase modulation

收稿日期:2018-08-21; 修订日期:2018-09-24

基金项目:国家自然科学基金(61505105,61535006);北邮开放课题 Open Fund of IPOC(BUPT)

作者简介:王奕方(1996-),女,硕士生,主要从事基于二维材料全光信号处理方面的研究。Email:yifangwang@sjtu.edu.cn 导师简介:吴侃(1983-),男,副教授,博士,主要从事激光器及微波光子学方面的研究。Email:kanwu@sjtu.edu.cn

0 引 言

自 2004 年石墨烯被发现以来,二维材料因其 独特的光子和光电特性引起了广大研究工作者的关 注^[1-3]。许多研究人员已经研究了基于石墨烯的新型 光电器件,像光学调制器^[4-5]、光开关^[6]和起偏器^[7]等。 自石墨烯被发现之后,过渡金属硫化物(TMDs)^[8-10]、 拓扑绝缘体(TI)^[11]、黑磷(BP)^[12-13]等也渐渐出现在研 究工作者的视野中。其中过渡金属硫化物(TMDs)因 其具有较高的光学非线性和饱和吸收特性已成为研 究热点。许多研究人员已经证明了这些 TMDs 可作 为可饱和吸收体应用于调 Q 光纤激光器及锁模激光 器中^[9]。

与此同时,全光信号处理因其具有高带宽和抗 电磁干扰等优点日益受到重视,全光方案在全光调 制、传感、路由等光通信中发挥着重要作用。基于石墨 烯的全光调制器和移相器已有相关报道^[4-6]。2017年, 笔者所在课题组采用在拉锥光纤上沉积少量硫化钨 (WS₂)的方法,并且结合马赫曾得干涉仪(MZI)实现 了移相器及全光开关,利用硫化钨材料的热光效应 和波长相关吸收获得高控制效率和低信号损耗^[14]。 然而,由于马赫曾得干涉仪的双臂结构使得该器件 对环境干扰较为敏感,导致输出信号稳定性欠佳。

在该工作的基础上, 文中基于偏振干涉并利用 材料的热光效应作为控制机制,实现了基于 MoS₂/ WSe2-PVA 薄膜的全光调制器。当 980 nm 控制光通 过波分复用器进入 MoS₂/WSe₂-PVA 薄膜后, MoS₂/ WSe2 材料吸收控制光,产生热量,通过热光效应改 变薄膜的折射率。由于材料在薄膜中分布的不均匀 和薄膜本身厚度的不均匀,1550 nm 信号光的两个 正交偏振分量会获得不同的相移,从而改变信号光 的偏振态,实现 980 nm 光对 1 550 nm 光的调制。得 到的 MoS₂-PVA 全光调制器的上升时间为 526 μs。 由于控制光和信号光在同一光束中传输,使得由空 气流动或温度变化等环境扰动引起的共模干扰对该 器件的影响变得很弱。因此,该器件与之前的 MZI 结构相比对环境扰动较不敏感,输出信号更稳定。此 外,采用薄膜形式因其紧凑性在实际应用中也有着 很大的优势。基于 MoS₂/WSe₂-PVA 薄膜的全光调制 器的实现证明了二维材料 TMDs 在光逻辑、光传感、

光路由等全光信号处理领域有着广阔的应用前景。

1 TMDs-PVA 材料的制备

二维材料的制备方法一般可以分成两大类:自 上而下和自下而上的方法^{15]}。自上而下主要是通过 打破分子层之间的范德华力将片状材料剥落到单层 或多层,主要包括机械剥离、激光减薄和溶液处理 等。自下向上的方式则是在分子层面直接合成相应 的纳米材料,主要包括化学气相沉积法、分子束外延 法、水热法、脉冲磁控溅射法、脉冲激光沉积法和气 相硫化法等。在此次实验中主要采用液相剥离法 (LPE)制备 TMDs-PVA 材料,该方法作为一种纯物 理溶液处理方法,直接采用高强度超声使材料分子 层之间产生微气泡,靠这股力量打破范德华力,经超 声处理后离心分离,再收集悬浮分层的二维纳米片。 在这个过程中,通过控制超声波的强度和离心过程 的时间,脱落的纳米片层数大致可以控制,该方法为 制备大量的单层和多层二维材料提供了一种简便和 低成本的方法而且又无需后续处理加工。

以 MoS₂-PVA 薄膜为例,其制备过程如下:首先 将 MoS₂ 颗粒和胆酸钠(SC)溶液混合,制成 5 mg/ml 的 MoS₂ 溶液,同时准备 50 mg/ml 聚乙烯醇(PVA)水 溶液,然后将 2 ml 的 MoS₂ 溶液和 10 ml 的聚乙烯醇 溶液混合,并且用磁力搅拌机充分混合 24 h。之后用 超声波处理混合物溶液 4 h,再从悬浮物中取适量混 合物滴到一个干净的培养皿表面,在 50 ℃下烘干 3~4 天,得到 MoS₂-PVA 薄膜。

2 实验方案与结果

2.1 MoS₂-PVA 材料吸收特性

制备了材料 MoS₂-PVA 后,为了可以更加充分的将材料应用到光电领域,文中测试材料的吸收特性,如图 1 所示。图 1(a)是将 MoS₂-PVA 薄膜裁剪后的形态图,图 1(b)是将其进一步裁剪成 1 mm×1 mm 大小附着在光纤头尾部的状态图,实验中用两个 FC/APC 光纤头通过法兰盘将其夹持在中间实现光 纤到薄膜的耦合。图 1(c)是 MoS₂-PVA 薄膜的吸收 特性在不同波长的分布图。可以发现 MoS₂-PVA 薄 膜随着波长增加损耗会相应减小。其中该薄膜对 980 nm 控制光的吸收损耗约为 6 dB,对 1 550 nm 信 号光的损耗约为 3.2 dB。这表明 MoS₂-PVA 薄膜对 980 nm 光具有较强吸收,因此实验中利用 MoS₂ 的 波长相关吸收,选择吸收强的 980 nm 波长作为控制 光,吸收弱的 1550 nm 波长作为信号光,从而在泵浦 波长处更高的吸收,以便更好地控制效率,而在信号 波长处更弱的吸收以降低损耗,最终获得高控制效 率和低信号损耗。



- 图 1 (a) MoS₂-PVA 薄膜照片; (b) MoS₂-PVA 薄膜转移到光纤 头的端面的照片; (c) MoS₂-PVA 薄膜的损耗特性
- Fig.1 (a) MoS₂-PVA thin film; (b) MoS₂-PVA film transferred onto a fiber end; (c) Loss of MoS₂-PVA thin film

2.2 基于 MoS₂/WSe₂-PVA 薄膜实现全光调制

图 2 是基于 MoS₂/WSe₂-PVA 薄膜实现全光调制 的实验装置图。980 nm 脉冲光作为控制光,1550 nm连 续光作为信号光,两束光的偏振态由偏振控制器(PC)





控制,通过 980/1550 波分复用器(WDM)合成一束 光,入射到经由法兰盘夹在光纤头尾端的 MoS₂/ WSe₂-PVA 薄膜上。在 MoS₂/WSe₂-PVA 薄膜之后经 过第二个波分复用器,用于滤除多余的 980 nm 泵浦 光。第二个波分复用器后,另一个偏振控制器和起 偏器用于选择出期望的信号光的偏振状态并输出 1550 nm 波长的调制脉冲信号。输出的调制脉冲信号用示波器(Aglient DSO9254A 2.5 GHz)和一个光电探测器来测量其时域波形。

器件的工作原理如下:以 MoS₂-PVA 薄膜为例, 当注入 980 nm 泵浦脉冲光后,根据热光效应,MoS₂ 吸收泵浦光产生热,使 MoS₂-PVA 薄膜的折射率发 生改变。而由于材料在薄膜中分布的不均匀和薄膜 本身厚度的不均匀性,1550 nm 信号光的两个正交 偏振态经历不同的相移,从而改变1550 nm 信号光 的偏振态。最后,通过调节光路中的3个 PC,实现最 佳的控制效率和输出特性。980 nm 脉冲光在光路中 的传输损耗约为 10 dB,其中包括 PC 和两个 WDM 的4dB 损耗以及 MoS₂ 材料的吸收损耗 6 dB。980 nm 脉冲光的重复频率为 50 Hz,方波信号的占空比为 20%,脉宽为 4 ms。980 nm 脉冲光进 MoS₂-PVA 薄膜 前的平均功率约为 160 mW。

基于 MoS₂-PVA 薄膜输出的调制脉冲信号的特 征如图 3 所示,其中图 3(a)黑色信号为归一化的输 出调制信号时域波形,棕色信号为输入的 980 nm 脉 冲光,由于热光效应的带宽限制,输出的调制信号的 上升沿和下降沿都变的比输入的 980 nm 信号要平 缓。图 3(b)黑色信号是单个输出调制信号的放大图, 按工程上计算信号功率的 10%~90%的上升时间的



- 图 3 (a)脉冲的控制光(棕色)和输出信号光(黑色);(b)关-开-关 状态的信号光(黑色)输出的放大图,以及指数拟合(蓝色); (c)长时间稳定脉冲输出序列
- Fig.3 (a) Pulsed control light (brown) and output signal (black);(b) A zoomed view of a single off-on-off transition of the output pulse (black) and exponential fit (blue); (c) A long-term stable output pulse train.

方法得到上升沿时间为 526 μs。通过用指数衰减函 数(1-exp(-t/τ_r))拟合上升沿,exp(-t/τ_r)拟合下降沿, 得到的上升沿时间常数 τ_r=324.5 μs,下降沿时间常 数 τ_r=353.1 μs,如图 3(b)蓝色曲线所示。输出调制信 号的上升沿时间常数是由 MoS₂ 吸收泵浦光产生热 量从而使薄膜温度升高这一加热过程决定的,而下 降沿时间常数仅仅与 MoS₂-PVA 薄膜的散热过程有 关。此外,实验中还研究了输出信号的长期稳定性, 如图 3(c)所示,得到了一串长期稳定的脉冲信号。这 表明与之前的 MZI 结构^[14]相比,采用偏振干涉的方 法可以有效地降低环境扰动带来的干扰。

对一个全光调制器而言,开关时间是一个重要 的参数。为验证输出的调制脉冲的上升沿时间是由 输入脉冲光的加热过程导致的且下降沿时间仅与散 热过程有关,实验中输入一组峰值功率相同但占空 比不同的脉冲信号,相应得到的调制信号如图 4(a) 所示。可以发现,输入占空比不同但峰值功率相同的 一组脉冲信号时得到的输出调制信号有着相同的上 升沿时间,即当泵浦脉冲的峰值功率相同时,其瞬间



- 图 4 (a)相同峰值功率不同占空比,及(b)不同峰值功率相同脉冲 能量时调制输出波形图;(c)相同峰值功率不同占空比,及(d) 不同峰值功率相同脉冲能量时上升沿/下降沿时间常数图
- Fig.4 Output signal pulses (a) when the pump pulses have same peak powers and different duty cycles, (b) when the pump pulses have same pulse energies and different peak powers; Time constant of rising edge/falling edge (c) when the pump pulses have same peak powers and different duty cycles, (d) when the pump pulses have same pulse energies and different peak powers

产生的热量是一样的。此外,还输入了一组峰值功率 不同但平均功率相同的脉冲信号,输出如图 4 (b)所 示。脉冲信号的占空比从 10%变到 50%,其相应的峰 值功率与占空比成反比关系。图 4(c)和图 4(d)汇总了 基于这两组测量结果拟合出的时间常数,从图中可以 清晰地发现,当峰值功率相同时,如图 4(c)所示,输出 信号的上升沿时间常数基本相同;当峰值功率不同 时,如图 4(d)所示,有较低占空比(较高峰值功率)的泵 浦脉冲产生的输出脉冲具有较快的上升时间。同时也 可以发现输出调制脉冲的下降时间并不随着峰值功 率的变化而变化,这也验证了前面所述的原理。

最后将 MoS₂-PVA 薄膜换成 WSe₂-PVA 薄膜, 也得到了调制输出。输入的 980 nm 脉冲光重复频率 为 500 Hz, 方波信号的占空比为 50%。 输出脉冲信 号如图 5(a)所示,验证了 WSe₂-PVA 薄膜也可实现 全光调制。图 5(b)黑色信号是单个输出调制信号的 放大图,蓝色曲线是按前面相同的指数拟合得到的 曲线。图 5(c)是得到的一串稳定的脉冲信号,验证了 偏振干涉的高稳定性。



- 图 5 (a) WSe₂-PVA 薄膜的调制输出信号光;(b) 调制信号光 (黑色)输出的放大图,以及指数拟合(蓝色);(c) 稳定脉冲 输出序列
- Fig.5 (a) Output signal of WSe₂-PVA thin film; (b) A zoomed view of the output pulse (black) and exponential fit (blue);(c) Stable output pulse train

3 结 论

文中主要研究了基于 MoS₂/WSe₂-PVA 薄膜利 用热光效应原理实现的全光调制器。采用偏振干涉 的机制,实现全光调制。基于 MoS₂-PVA 薄膜输出调 制信号的上升沿时间为 526 μs, 上升沿时间常数为 324 μs。与之前报道的 MZI 结构相比,该器件对环境 扰动不敏感,因此能够得到一串长时间稳定输出的 脉冲。此外,材料采用薄膜形式具有实现紧凑器件结 构的可能性,方便将其应用于实际中。笔者的工作将 有益于对二维材料 TMDs 在光子学应用方面的研 究,使得二维材料 TMDs 在光逻辑、光传感、光路由 等全光信号处理领域具有更广阔的应用前景。

参考文献:

- Bonaccorso F, Sun Z, Hasan T, et al. Graphene photonics and optoelectronics[J]. Nature Photonics, 2010, 4: 611-622.
- [2] Gong Shuang, Tian Jinrong, Li Kexuan, et al. Advances in new two-dimensional materials and its application in solidstate lasers[J]. Chinese Optics, 2018, 11: 18-30. (in Chinese) 公爽,田金荣,李克轩,等.新型二维材料在固体激光器中 的应用研究进展[J]. 中国光学, 2018, 11: 18-30.
- [3] Feng Dejun, Huang Wenyu, Ji Pengyu, et al. Erbium-doped fiber ring cavity pulsed laser based on graphene saturable absorber [J]. Opt Precision Eng, 2013, 21: 1097-1101. (in Chinese)
 冯德军,黄文育,纪鹏宇,等.基于石墨烯可饱和吸收体的 掺铒光纤环形腔脉冲激光器 [J]. 光学 精密工程, 2013, 21: 1097-1101.
- [4] Li W, Chen B G, Meng C, et al. Ultrafast all-optical graphene modulator[J]. Nano Letters, 2014, 14: 955-959.
- [5] Zhou Feng, Jin Xiaofeng. All-fiber graphene electro-absorption modulator[J]. Opt Precision Eng, 2016, 24: 2117-2125. (in Chinese)
 周锋,金晓峰.全光纤结构的石墨烯电吸收调制器 [J].光学精密工程, 2016, 24: 2117-2125.
- [6] Gan X T, Zhao C Y, Wang Y D, et al. Graphene-assisted all-fiber phase shifter and switching [J]. Optica, 2015, 2:

468-471.

- [7] Bao Q, Zhang H, Wang B, et al. Broadband graphene polarizer[J]. Nature Photonics, 2011, 5: 411.
- [8] Liu W J, Pang L H, Han H N, et al. Tungsten disulphide for ultrashort pulse generation in all-fiber lasers [J]. Nanoscale, 2017, 9: 5806-5811.
- [9] Wu K, Zhang X Y, Wang J, et al. WS₂ as a saturable absorber for ultrafast photonic applications of mode-locked and Q-switched lasers[J]. Optics Express, 2015, 23: 11453-11461.
- [10] Chu Xueying, Sha Xue, Xu Mingze, et al. Applcation of Raman scattering properties of transition metal dichalcogenides in immunoassays [J]. Opt Precision Eng, 2018, 26: 572-577. (in Chinese)
 楚学影,沙雪,徐铭泽,等.过渡金属二硫化物拉曼散射在 免疫检测中的应用[J].光学 精密工程, 2018, 26: 572-577.
- [11] Yan P G, Lin R Y, Ruan S C, et al. A practical topological insulator saturable absorber for mode-locked fiber laser [J]. Scientific Reports, 2015, 5: 5.
- [12] Huang M Q, Wang M L, Chen C, et al. Broadband blackphosphorus photodetectors with high responsivity [J]. Advanced Materials, 2016, 28: 3481–3485.
- [13] Luo Z C, Liu M, Guo Z N, et al. Microfiber-based fewlayer black phosphorus saturable absorber for ultra-fast fiber laser[J]. Optics Express, 2015, 23: 20030-20039.
- [14] Wu K, Guo C S, Wang H, et al. All-optical phase shifter and switch near 1 550 nm using tungsten disulfide (WS₂) deposited tapered fiber[J]. Optics Express, 2017, 25: 17639– 17649.
- [15] Wu K, Chen B, Zhang X, et al. High-performance modelocked and Q -switched fiber lasers based on novel 2D materials of topological insulators, transition metal dichalcogenides and black phosphorus: review and perspective (invited)[J]. Optics Communications, 2018, 406: 214-229.